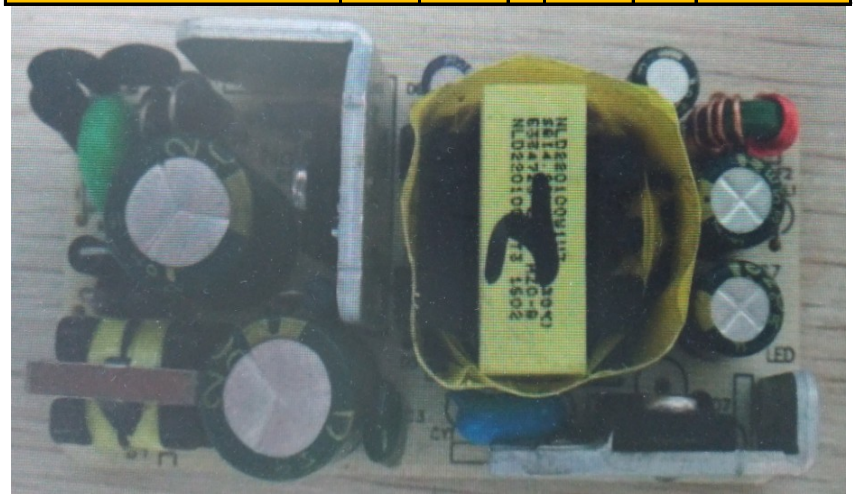
六级能效12V2A方案竞品对比

PN8160T+EE22加厚(AE=50)+SB20100L							
Description		Symbol	Min	Typ	Max	Units	Comment
Input							
Voltage		Vin	90		264	V	
Frequency		fLIN	47		60	Hz	
No-load Input Power(230V)					60	mW	
Output							
12V/2A	Output Voltage	Vout	12.18		12.26	V	
	Output Current	Iout	0		2	A	
	Over Current Protecti	Iocp			2.7	A	
	Ripple & Noise	Vripple			88	mVP_P	
	Average Efficiency	η	88.81%				COC V5 T2
Ambient Temperature		Tamb	0		40	° C	

PF6116+EE22加厚（AE=50)+4N65＋SB20100L							
Description		Symbol	Min	Typ	Max	Units	Comment
Input							
Voltage		Vin	90		264	V	
Frequency		fLIN	47		60	Hz	
No-load Input Power(230V)					75	mW	
Output							
12V/2A	Output Voltage	Vout	11.95		12.15	V	
	Output Current	Iout	0		2	A	
	Over Current Protecti	Iocp			2.7	A	
	Ripple & Noise	Vripple			100	mVP_P	
	Average Efficiency	η	87.70%				DOE LEVEL VI
Ambient Temperature		Tamb	0		40	° C	



PN8160T方案特点：

1：无需高压启动电阻，待机功耗轻松低于60MW
2：QR-PWM+QR-PFM+Burst Mode多模式，效率高
3：高低压分频（65K/85K），高压应用可小一号变压器
4：EMI特性好，变压器不需屏蔽（输出加共模）
5：CS电阻内置，节省布板空间，节省3-4个贴片
6：功率密度大，内置1.6欧MOS叠层封装，全电压IC仅需小散热片,肖特基无需散热片
7：VDD电压超宽8-40V，变压器易设计，特别适合快充
8：超强保护，输出过压，过流，过温，VDD欠过压，二极管短路
9：超高可靠性，MOS耐压690V,HBM ESD大于4kV Latchup电流大于200mA
10：成本低，较分离MOS方案成本低0.6-1.0元